

	<h2 style="color: red;">SI4435DDY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4435DDY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 11.4A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4435DDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 99509 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4435DDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 11.4A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	99509 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 9.1A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.4A (Tc)

SI4435DDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4435DDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4435DDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4435DDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOP</p>	 <p>SI4435DDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11.4A 8SOIC</p>	 <p>SI4435DY Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DDY-T1-E3. VISHAY SI4435DDY-T1-E3. VISHAY</p>
 <p>SI4435DY-A VISHAY</p>	 <p>SI4435DY AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11.4A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DY Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p>

SI4435DDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4435DDY-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI4435DDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4435DDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4435DDY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4435DDY-T1-GE3
SI4435DDY-T1-GE3 Electronic	SI4435DDY-T1-GE3-Komponenten	SI4435DDY-T1-GE3-Verteiler	SI4435DDY-T1-GE3-Bild	SI4435DDY-T1-GE3-Bild	SI4435DDY-T1-GE3-Teil
SI4435DDY-T1-GE3 Preis	SI4435DDY-T1-GE3 Hersteller	SI4435DDY-T1-GE3 Bild	SI4435DDY-T1-GE3 Aktie	SI4435DDY-T1-GE3 Inventar	SI4435DDY-T1-GE3 Inventar
SI4435DDY-T1-GE3 Neu	SI4435DDY-T1-GE3 Original	SI4435DDY-T1-GE3 garantiert	SI4435DDY-T1-GE3 RFQ	SI4435DDY-T1-GE3 Online bestellen	SI4435DDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited